






	<h2 style="color: red;">FDP12N50</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP12N50</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP12N50.pdf 2.FDP12N50.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19018 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP12N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19018 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11.5A (Tc) 165W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1315pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP12N50 ist neu im Original, Suche FDP12N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP12N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP12N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP120AN15AO VB FDP120AN15AO VB</p>	 <p>FDP12N50NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP12N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>
 <p>FDP120AN15AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>	 <p>FDP12N60C FSC FDP12N60C FSC</p>	 <p>FDP120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p>FDP12N50NZ FSC FDP12N50NZ FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FDP070AN06A0	↔ FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06A0	D FDP075N15A	⇒ FDP075N15A
⊕ FDP083N15A	⊕ FDP083N15A	D FDP083N15A_F102	⇒ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A
⊕ FDP085N10A_F102	⊕ FDP090N10	⊕ FDP090N10	↔ FDP100N10	⇒ FDP100N10
D FDP10AN06A0	⊕ FDP10AN06A0	⊕ FDP10AN06A0	⊕ FDP10N60NZ	⇒ FDP10N60NZ
⇒ FDP120AN15A0	↔ FDP120AN15A0	⊕ FDP120AN15A0	⊕ FDP120N10	⇒ FDP120N10
↔ FDP12N50	⇒ FDP12N50NZ	D FDP12N50NZ	⊕ FDP12N60NZ	⊕ FDP12N60NZ
⊕ FDP13AN06A0	D FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	↔ FDP14AN06LA0	⇒ FDP14AN06LA0
⊕ FDP14AN06LA0	⊕ FDP14N60	↔ FDP150N10	⇒ FDP150N10	⇒ FDP150N10A
⊕ FDP150N10A	⊕ FDP150N10A_F102	⊕ FDP15N40	D FDP15N40	⇒ FDP15N50
↔ FDP15N50	⊕ FDP15N65	⊕ FDP15N65	⊕ FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN08A0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited